機能性表面処理技術と評価に関する研究

宫城友昭**•髙橋芳朗**•園田正樹**•秋本恭喜*** *金属担当•***電子•情報担当

Research of Functional Surface Treatments and Evaluating Methods

*Tomoaki MIYAGI•*Yoshiro TAKAHASHI•*Masaki SONODA•**Yasuki AKIMOTO *Metallurgy Section **Electronics and Information Engineering Section

要 旨

センターの要素技術として機能性表面処理技術や評価技術を蓄積し、県内企業の技術支援、技術力向上、センターの試験高度化を目指すため、本研究に取り組んだ.表面処理の一手法として光触媒に着目し、スパッタリング法で多層膜・混晶膜を作製および評価することで、弱光環境下での触媒活性の向上を目指している.本年度は、TiO₂薄膜の特性を調べるため、ガラス基板上にTiO₂薄膜を作製し、その光学特性評価と結晶構造解析を行った.その結果、光学特性評価からは、成膜時間が長いほど紫外光波長領域(200~380nm)での透過率が減少すること、チャンバー圧力は低く、酸素ガスを導入しない方が成膜速度が大きくなること、膜厚が厚くなると反射率が増加することなどが分かった.また結晶構造解析からは、アナターゼ型の(101)面のピークが出ていること、加熱によりピークが増大したり、他の結晶面のピークも現れることが分かった.

1. はじめに

材料の表面に膜を塗布したり,電気的または化学的に めっきを施したり,蒸着や熱処理を行うことで,母材に はない機能を付加させる機能性表面処理技術への期待は 非常に大きい.近年 IoT や EV 車などが注目を浴び,電子 デバイスの重要性がより高まっていることもあり,表面 処理技術とその評価技術を向上させることは必要不可欠 となっている.大分県には自動車や半導体,医療をはじ め様々な分野の産業が集積しているが,製品の表面処理 やその評価に関する技術相談は多く,かつ内容も多岐に 渡っている.

一方,防汚・抗菌作用を持つ光触媒技術は,建材に利 用されているだけでなく,半導体や食品,医療機器メー カが抱える技術的課題¹⁾の解決に応用が期待されてい る.しかし,基材への均一な薄膜作製や弱光環境下での 触媒活性が課題となっている¹⁾.そこで,スパッタリン グ法による光触媒多層膜・混晶膜の作製や評価により課 題解決を目指し,シーズ技術を構築するとともに,それ らを通じて得られた技術や知見を県内企業の技術支援や 技術力向上,センターの試験高度化に広く活用する.本 年度は,スパッタリング法によってガラス基板上にTiO₂ 薄膜の作製および評価を行ったので,以下に報告する.

2. 実験方法

2.1 基板

TiO₂ 薄膜を作製する基板として,ホウケイ酸ガラス 7059(ガラス基板:φ2inch×t1mm)を用いた.ブロワーで 表面の付着物を除去して,実験に供した.

2.2 スパッタリング装置

スパッタリング装置として、アルバック社製ヘリコンスパッタ MUE-201C-HC3 を使用した.装置全体の写真を Fig.1 に示 す.成膜室には RF カソードが 3 個あり、試料ホルダーは それらの上方にセットする.また、チャンバー外部より アルゴンガスや酸素ガスを導入できるようになってい る.ガス流量はマスフローメータで調整する.



Fig.1 スパッタリング装置の写真

2.3 成膜条件

スパッタリング装置で成膜するときの各パラメータを Table 1に示す.本研究では成膜速度の最適条件を調べ るため,チャンバー圧力とスパッタガス中の酸素ガスの 有無に着目し,以下に示す条件①~③を設定して成膜を 行った.

	条件①	条件②	条件③
チャンバー	1 Pa	0.1 Pa	0.1 Pa
圧力			
スパッタ	Ar, 0_2	Ar, 0_2	Ar のみ
ガス	(3:1)	(3:1)	
ターゲット			
一試料間の	150 mm	150 mm	150 mm
距離			
RF 電力	200 W	200 W	200 W
基板温度	室温	室温	室温
スパッタ	1, 2, 4, 10 h	1,4,8 h	1, 4, 8, 16,
時間	(3Pa で 2h)		24 h

Table 1 成膜条件

2.4 分光光度計による光学特性評価

作製した薄膜の光学特性(透過率および反射率)を測定 するため、分光光度計(島津製作所 SolidSpec-3700)を使 用した.この装置には膜厚計測ソフトウェアが付属して おり、これにより膜厚測定も行った.干渉波形の山と谷 の波長より、試料の屈折率および入射角を既知の値とし て代入し、膜厚を計算するものである.

2.5 X線回折による結晶構造解析

作製した薄膜の結晶構造や結晶性を調べるため,100nm 以下の薄膜や微小部解析も可能な X 線回折装置(リガク Smartlab)を使用した.

3. 実験結果および考察

3.1 分光光度計による光学特性評価

Fig. 2 および Fig. 3 に,条件①でガラス基板上に作製 した TiO₂薄膜の透過率および反射率を示す.試料は成膜 時間が 0, 1, 2, 4, 10 時間のものを示し,全圧 3Pa で 2 時間 成膜したものも比較データとして併載した.測定した波 長領域は 200~800nm である.これを見ると,成膜時間が 増加すると紫外光波長領域 (200~380nm)の透過率が徐々 に低下していくことが分かった.また,10 時間成膜した 試料では,曲線が正弦波に近い概形を描いており,透過 光の干渉が見られ始めている.また,成膜条件(チャンバ ー圧力)比較用に作製した 3Pa で 2 時間の試料について, 1Pa で 2 時間成膜したものと比較すると,透過率の減少 は小さいことから, 1Pa の時の方が成膜速度は大きいこ とが分かった.反射率については,いずれの試料も 0.4% 以下であり,ほぼ反射していないことが分かった.



Fig.2 条件①でガラス基板上に作製した TiO₂薄膜の透過率



 Fig.3
 条件①でガラス基板上に作製した TiO₂薄膜の反射率

また, Fig. 4 および Fig. 5 に, 条件③でガラス基板上に作 製した TiO₂ 薄膜の透過率および反射率を示す. 成膜時間 を長くすると,紫外光波長領域(200~380nm)の透過率は, 条件①で作製した TiO₂ 薄膜の透過率よりもさらに減少 した. また, 4 時間以上成膜した試料からは,干渉も見 られるようになった. これは,それだけ膜厚が大きくな っていることを意味しており,干渉が現れなかった条件 ①の時よりも成膜速度は大きいと考えられる. 反射率測 定からは, 16 時間, 24 時間のように膜厚が厚い試料では 干渉が見られた. また, 16 時間, 24 時間では全体的に反 射率は上昇していることが分かった.これは、アナター ゼ型 TiO₂の屈折率が 2.52 と高いことに加え²⁾、ガラス 基板上の TiO₂ 薄膜の膜厚が大きくなって透過率が減少 したことが関係していると考えられる.



Fig.4 条件③でガラス基板上に作製した TiO₂薄膜の透過率



Fig.5 条件③でガラス基板上に作製した TiO₂薄膜の反射率

条件③でガラス基板上に作製した TiO₂ 薄膜の膜厚に ついて,透過率測定結果から膜厚測定ソフトを使用して 算出した結果を Table 2 に示す.ただし,条件①で成膜 した試料は膜厚が小さくて干渉が完全に確認できなかっ たため,本ソフトでの測定は不可能であった.これをプ ロットしてグラフ化したものを Fig.6 に示す.この傾き より成膜速度を求めたところ,83nm/h となった.

Fig. 7 および Fig. 8 に,条件①~③でガラス基板上に 4 時間作製した TiO₂ 薄膜の透過率および反射率を示す.条件②の透過率は条件①よりも減少し,さらに条件③では 干渉が見られていることから,膜厚は条件③>条件②> 条件①の順に厚くなった.すなわち,チャンバー圧力が

 Table 2
 条件③でガラス基板上に作製した

 Ti0₂薄膜の成膜時間と膜厚

成膜時間 [時間]	膜厚 [μm]	
4	0.36	
6	0.51	
8	0.67	
16	1.48	
24	1.78	



 Fig.6
 条件③でガラス基板上に作製した Ti0₂薄膜の

 成膜時間と膜厚の関係

低い、また酸素ガスがない時の方が、成膜速度は高いこ とが分かった.チャンバー圧力が高いほど、スパッタさ れたチタン原子や酸素原子と、スパッタガス中のアルゴ ン原子や酸素分子などとの間で起こる衝突回数が増加 し、方向変化や減速によって基板に到達する確率が減少 するため、成膜速度は低下することが考えられる.また、 スパッタガスに酸素を含めると、ターゲットから放出された 酸素原子の一部が,スパッタガス中の酸素分子によって修復 されて,再びターゲットに戻る. 今回の TiO,ターゲットのよう に,酸化物のターゲットを用いてスパッタを行う場合,酸素原 子が選択的にスパッタされる³⁾. これにより, TiO, ターゲット表 面に酸素原子が修復された後も,さらに酸素原子が選択的 にスパッタされて、その一部が修復される現象が繰り返される ことで、TiO。ターゲット表面の酸素原子の密度が次第に増加 し,酸素原子に覆われた状態となる.それ故に、チタン原子 のスパッタが起こりにくくなり, 成膜速度を低下させる と考えられる³⁾. また反射率は, いずれの試料も 0.4%以下 であり、ほぼ反射していないことが分かった.



Fig.7 条件①~③でガラス基板上に4時間作製した Ti0,薄膜の透過率



 Fig.8
 条件①~③でガラス基板上に4時間作製した

 Ti0,薄膜の反射率

3.2 X線回折による結晶構造解析

Fig.9およびFig.10に,条件①および条件③でガラス 基板上に作製したTiO₂薄膜のX線回折結果を示す.これ より,いずれの試料も25°近傍の位置にピークが表れて いることが分かった.TiO₂の結晶構造の1つであるアナ ターゼ型結晶は25°で(101)面の最強度ピークを示すの で,アナターゼ型結晶のTiO₂薄膜が形成されていること が分かった⁴⁾.また,(004)面のピークについてもバック グラウンドに埋れかかってはいるが,40°近傍に確認さ れた.しかし,(101)面のピークの形状はブロードである ことから,いずれの試料も結晶が小さいもしくはアモル ファスに近い状態になっていると考えられる.ピークの 強度や半値幅について,条件①と条件③の試料で大きな 違いは見られなかった.



Fig.9 条件①でガラス基板上に作製した TiO₂薄膜のX線回折結果



Fig. 10 条件③でガラス基板上に作製した TiO₂薄膜のX線回折結果

次に,本研究では基板温度を室温のままで行ったので, 試料を加熱して結晶性が向上するかどうかを調べた. Fig. 11 に,条件③でガラス基板上に24時間作製したTiO₂ 薄膜を300℃で1時間および2時間加熱した時のX線回 折結果を示す.これより,加熱前と比べて1時間加熱後 にピークの変化は見られなかったが,2時間加熱後の (101)面のピークが鋭くなった.また,(004)面や(300) 面など,他の結晶面のピークが現れていることから,結 晶性が向上していることが分かった.



Fig. 11 条件③でガラス基板上に 24 時間作製した TiO₂薄膜を 300℃で1時間および2 時間 加熱した X 線回折結果

4. まとめ

センターの要素技術として機能性表面処理技術や評価 技術を蓄積し,県内企業の技術支援,技術力向上,セン ターの試験高度化を目指すため,本研究に取り組んだ. 表面処理の一手法として光触媒に着目し,スパッタリン グ法で多層膜・混晶膜を作製および評価することで,弱 光環境下での触媒活性の向上を目指している.本年度は, Ti0₂薄膜の特性を調べるため,ガラス基板上にTi0₂薄膜 を作製し,その光学特性評価と結晶構造解析を行った. (1)分光光度計による光学特性評価

- ・成膜時間が長いほど、紫外光波長領域(200~380nm)の
 透過率は減少した。
- ・チャンバー内の圧力が低く,酸素ガスを導入しない方が成 膜速度は大きくなった.
- ・チャンバー圧力が 0.1Pa, アルゴンガスのみでスパッタした 場合の成膜速度は, 83nm/hとなった.
- ・膜厚が厚くなると、反射率が上昇した.
- (2) X 線回折による結晶構造解析
- ・アナターゼ型結晶の(101)ピークが出ていることを確認した.
- ・300℃で2時間加熱すると、(101)ピークが鋭くなり、(004)や (300)と見られるピークも現れることが分かった.

5. 参考文献

 1)橋本和仁,藤嶋昭:図解 光触媒のすべて,オーム社, p75-77
 2)清野学:酸化チタン-物性と応用技術-,技報堂出版, p52 3) 星陽一: TiO₂ 膜の高速低温スパッタ成膜法,日本真空 学会誌(2014), Vol57, No.1, p9 4) 坂間宏, 鋤柄琢磨,小野敦,野村憲吾,田野倉敦,市 川能也: RF マグネトロンスパッタリング法を用いて作製 した TiO₂ 薄膜の光触媒活性,表面科学(2004) Vol.25, NO.3, p164